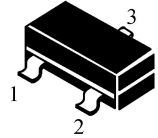




GM807(銷售型號 BC807)

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP Low Frequency Amplifier Transistor

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極發射極電壓	$V_{CEO}$	-45	V
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	$V_{CBO}$	-50	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	-5.0	V
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續	$I_c$	-500	mA

■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) $T_A=25^{\circ}C$ 溫度為 $25^{\circ}C$ Derate above $25^{\circ}C$ 超過 $25^{\circ}C$ 遞減	$P_D$	225 1.8	mW mW/ $^{\circ}C$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^{\circ}C$ Derate above $25^{\circ}C$ 超過 $25^{\circ}C$ 遞減	$P_D$	300 2.4	mW mW/ $^{\circ}C$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	417	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature] 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	-55to+150 $^{\circ}C$	

■DEVICE MARKING 打標

GM807-16(BC807-16)=5A; GM807-25(BC807-25)=5B; GM807-40(BC807-40)=5C

GM807(銷售型號 BC807)

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
---------------------	-----------	---------	---------	---------

■OFF CHARACTERISTICS 截止電特性

Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極發射極擊穿電壓 (Ic= -10mA, IB=0)	V <sub>(BR)CEO</sub>	-45	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極基極擊穿電壓 (Ic= -10μA, VEB=0)	V <sub>(BR)CBS</sub>	-50	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極基極擊穿電壓 (IE= -1.0μA, Ic=0)	V <sub>(BR)EBO</sub>	-5.0	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流(VCB=-20V) (VCB= -20V, TA=150°C)	ICBO	— —	-100 -5.0	nA uA

■ON CHARACTERISTICS 導通電特性

DC Current Gain 直流電流增益	H <sub>FE</sub>			—
(Ic= -100mA, VCE= -1.0V)	807-16	100	250	
	807-25	160	400	
	807-40	250	600	
(Ic= -500mA, VCE= -1.0V)		40	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降(Ic= -500mA, IB= -50mA)	V <sub>CE(sat)</sub>	—	-0.7	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降(Ic= -500mA, IB= -50mA)	V <sub>BE(sat)</sub>	—	-1.2	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓(Ic= -500mA, VCE= -1.0V)	V <sub>BE(on)</sub>	—	-1.2	V

■SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS 小信號特性

Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益-帶寬乘積 (Ic= -10mA, VCE= -5.0V, f=100MHz)	f <sub>T</sub>	100	—	MHz
Output Capacitance 輸出電容(VCB= -10V, f=1.0MHz)	C <sub>obo</sub>	—	10	pF

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.